ГУАП

КАФЕДРА № 42

ОТЧЕТ ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКО	й		
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ			
канд. техн. наук, дог			А.В. Аграновский
должность, уч. степень, з	вание	подпись, дата	инициалы, фамилия
O	ГЧЕТ О ЛАБ	БОРАТОРНОЙ РАБО	OTE №1
И	сследование	полупроводниковог	о диода
по куј	рсу: ЭЛЕКТІ	РОНИКА И СХЕМО	ТЕХНИКА
РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ			
СТУДЕНТ ГР. №	4329	подпись, дата	Д.С. Шаповалова инициалы, фамилия

Содержание

1. Цель работы:	3
2. Задание:	3
3. Схема экспериментальной установки	4
4. Таблица с результатами практических исследований	4
5. ВАХ диода	5
6. Вывод	7

1. Цель работы:

Изучение и практическое исследование работы и характеристик полупроводникового диода.

2. Задание:

1. С помощью приложения MICROCAP собрать следующую схему. При этом из библиотеки MICROCAP необходимо взять полупроводниковый диод типа 5082-2207. Сопротивление резистора R принять равным 1 Ом.

В рассматриваемой схеме напряжение U ИСТ источника постоянного тока делится между последовательно включенными диодом и резистором.

U ИСТ = U Д + U R. Падение напряжения на резисторе находится из соотношения U R = I Д × R, где I Д - ток диода.

Поскольку сопротивление резистора равно 1 Ом, то U R = I Д. Следовательно, для определения тока диода достаточно измерить напряжение на резисторе. Напряжение на диоде можно найти из соотношения U Д = U H CT - U R.

2. Произвести исследование ВАХ диода. При этом по вышеизложенной методике для каждого значения напряжения источника U ИСТ необходимо найти значение напряжения между анодом и катодом UД и ток диода IД Данные исследований занести в таблицы.

Таблица 1

$U_{ m HCT}$, B	0	0,2	0,4	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,2	1,4
$I_{ m Д}$, м ${ m A}$										
$U_{ m Д}$, В										

Таблица 2

U_{HCT} , B	-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
$I_{\rm Д}$, м ${ m A}$												
$U_{ m Д}$, В												

Рисунок 1 – Таблицы с требуемыми значениями напряжения источника.

3. Схема экспериментальной установки

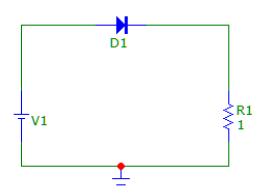


Рисунок 2 – Схема цепи.

4. Таблица с результатами практических исследований

На таблице 1 представлены результаты измерений силы тока диода и вычислений напряжения диода, при положительном напряжении источника тока, то есть прямая ветвь.

Таблица 1 – Результаты измерений и вычислений, прямое напряжение

U ИСТ,В	0	0,2	0,4	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,2	1,4
ІД, мА	0,0	0,0	0,5	16,9	30,8	45,6	61,0	76,6	108,3	140,4
U Д, В	0,0	0,2	0,4	0,6	0,7	0,8	0,8	0,9	1,1	1,3

На таблице 2 представлены результаты измерений силы тока диода и вычислений напряжения диода, при отрицательном напряжении источника тока, то есть обратная ветвь.

Таблица 2 – Результаты измерений и вычислений, обратное напряжение

U ИСТ,В	-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
I Д, мА	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-122,9	-285,6	-450,5	-615,5	-781,0	-946,7	-1113,0
U Д, В	-1,0	-2,0	-3,0	-4,0	-5,0	-5,9	-6,7	-7,5	-8,4	-9,2	-10,1	-10,9

5. ВАХ диода

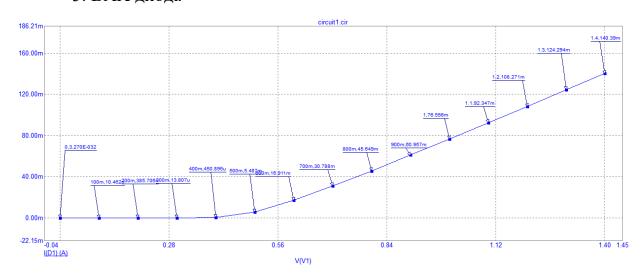


Рисунок 3.1 - BAX полупроводникового диода, прямая ветвь, график из программы Micro-Cap

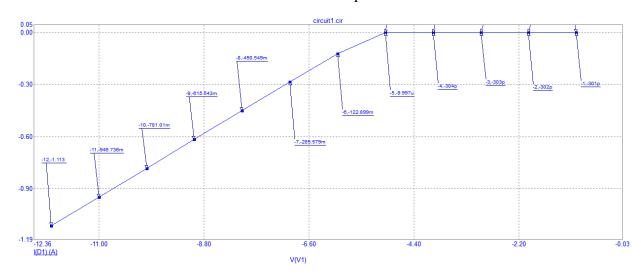


Рисунок $3.2 - {\rm BAX}$ полупроводникового диода, обратная ветвь, график из программы Micro-Cap

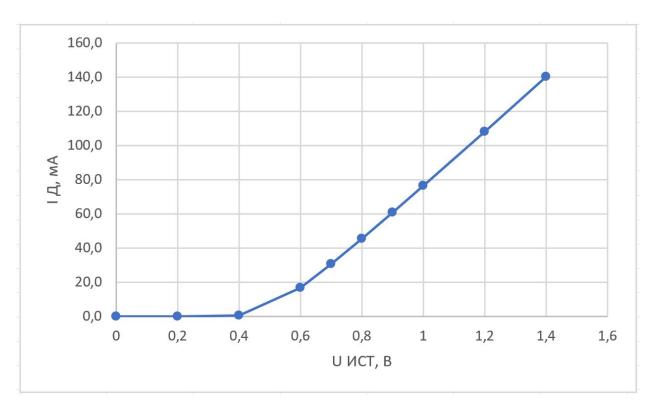


Рисунок 3.3 - BAX полупроводникового диода, прямая ветвь, график из приложения Excell

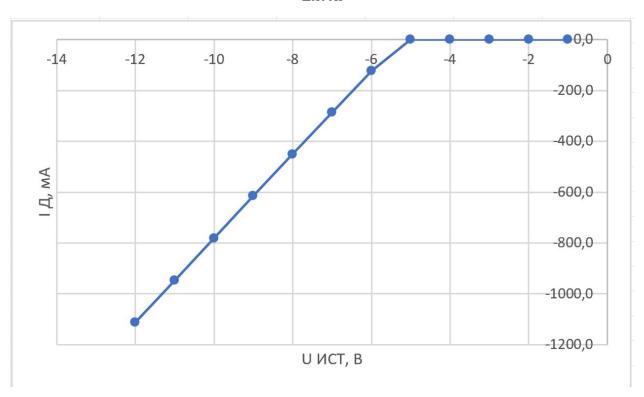


Рисунок 3.4 - BAX полупроводникового диода, обратная ветвь, график из приложения Excell

На представленных рисунках 3.1-3.4 мы можем наглядно наблюдать, как изменяется сила тока диода, при изменении значения напряжения источника тока, в случае прямого и обратного напряжения.

6. Вывод

В данной работе мы подробно рассмотрели работу и характеристики полупроводникового диода обратной и прямой ветви, то есть при положительном напряжении и отрицательном.

В результате выполнения лабораторной работы мы, с помощью приложения Місто-Сар, собрали схему, состоящую из диода, резистора, заземления и источника постоянного тока. Для полученной схемы мы меняли напряжение источника и следили за изменением силы тока диода, из полученных данных вычисляли напряжение диода, учитывая сопротивление в 1 Ом.

В процессе работы была построена BAX диода, которая имеет две ветви: прямую и обратную.

В прямой ветви мы можем наблюдать:

- 1) На участке от 0 до 0.4 B сила тока равна 0, что говорит о том, что p-n переход закрыт.
- 2) После 0,4 В сила тока начинает стремительно возрастать, что говорит о том, что p-n переход открылся.

В обратной ветви мы можем наблюдать:

- 1) На участке от -1 до -5 В сила тока равна 0, значит р-п переход закрыт.
- 2) После напряжения в -5 В происходит пробой диода, через него начинает протекать обратный ток. Сила тока резко увеличивается.

Таким образом, в процессе лабораторной работы были изучены работа и характеристики полупроводникового диода обратной и прямой ветви, зависимость силы тока диода, от подаваемого источником тока напряжения.